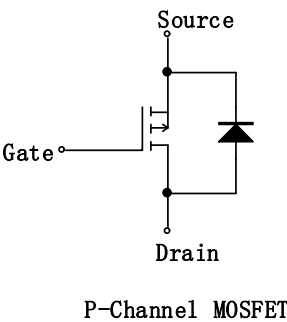
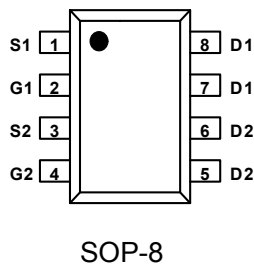


4953

20V P 沟道增强型 MOS 场效应管

VDS= -20V
RDS(ON), Vgs@-4.5V, Ids@-3A = 62mΩ@TYP
RDS(ON), Vgs@-2.5V, Ids@-2.5A = 88mΩ@TYP



特点

- 先进的沟道工艺技术
- 高密度超低电阻设计
- 改良的成形工艺

最大额定值和热特性(TA = 25℃，除非另有说明)

参数	符号	值	单位
漏源电压	V _{DS}	-20	V
栅源电压	V _{GS}	±12	
漏极电流	I _D	-3	A
漏极脉冲电流	I _{DM}	-1	
工作结温和存储温度范围	T _J , T _{stg}	-50 to 150	℃

注：重复性极限值：脉冲宽度由最高结温限制。

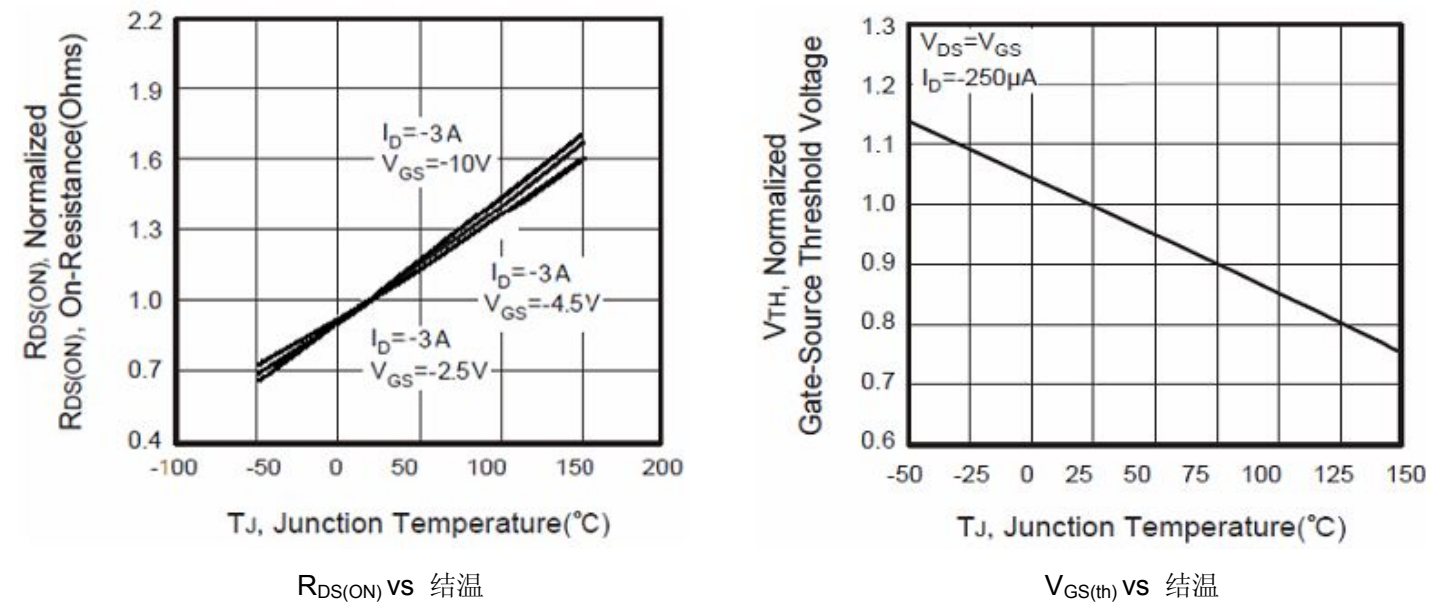
4953

20V P 沟道增强型 MOS 场效应管

电特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
静电						
漏源击穿电压	B _{VDSS}	V _{GS} = 0V, I _D = -250uA	-20	--	-23	V
漏源电阻	R _{DS(on)}	V _{GS} = -4.5V, I _D = -3A	--	62.0	90.0	mΩ
	R _{DS(on)}	V _{GS} = -2.5V, I _D = -3A	--	88.0	120.0	
栅极阈值电压	V _{GS(th)}	V _{DS} = V _{GS} , I _D = -250uA	-0.4	-0.7	-1	V
漏极到源极的漏电流	I _{DSS}	V _{DS} = -20V, V _{GS} = 0V, T _J =25℃	--	--	1	uA
栅极到源极的漏电流	I _{GSS}	V _{GS} = ±12V	--	--	±100	uA
漏极持续电流	I _D				-3	A

温度 VS R_{DS(ON)}/V_{GS(th)}

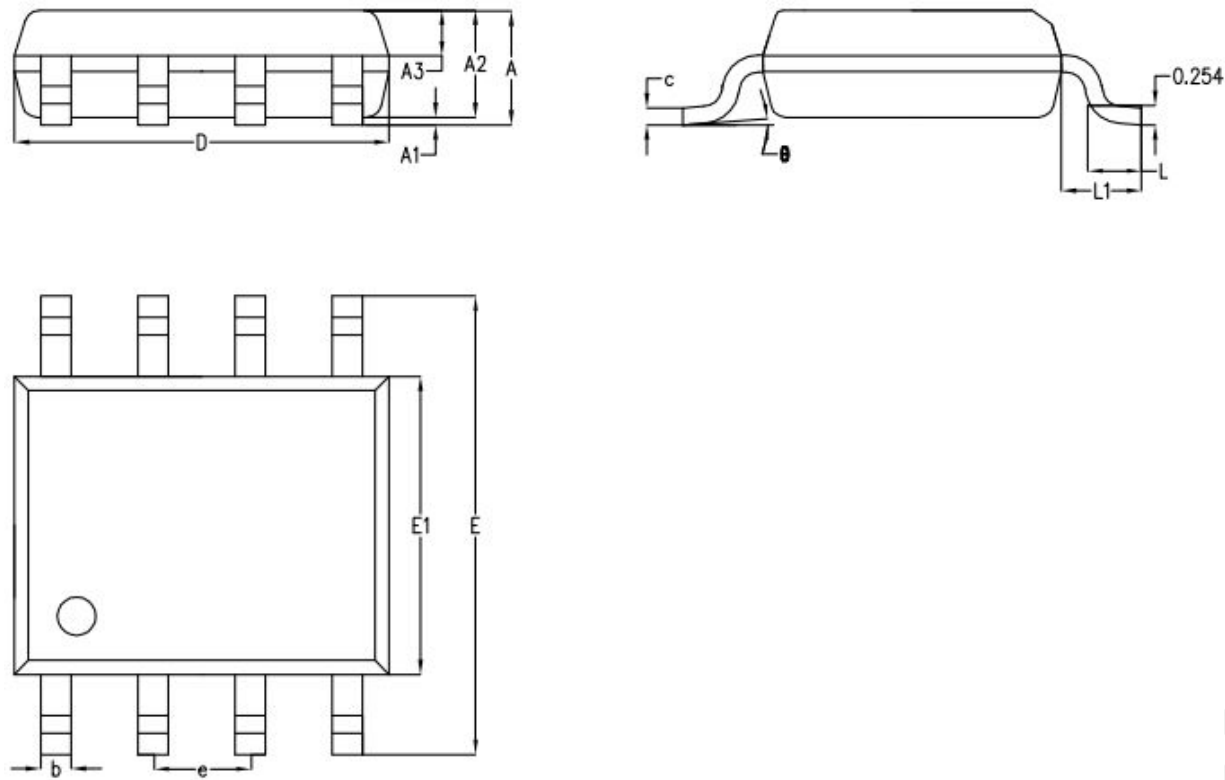


4953

20V P 沟道增强型 MOS 场效应管

封装信息

SOP-8



符号	毫米		
	最小值	典型值	最大值
A	-	1.50	1.55
A1	-	0.10	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.55	0.60	0.65
b	0.35	0.40	0.45
c	0.17	0.22	0.25
D	4.85	4.90	4.95
E	5.90	6.00	6.10
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
L	0.60	0.65	0.70
L1	1.05BSC		
θ	0°	4°	6°